

OGŁOSZENIE O PRACĘ

INSTYTUCJA: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Institut Mikroelektroniki i Fotoniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Główny specjalista ds. epitaksji, 100% etatu

DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka, fizyka techniczne, elektronika, inżynieria materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 8.10.2025

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2025

LINK DO STRONY: <https://imif.lukasiewicz.gov.pl/>

SŁOWA KLUCZOWE: fotonika, epitaksja, wzrost heterostruktur półprzewodnikowych, MBE, MOCVD

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI

poszukuje Kandydata na stanowisko

Główny specjalista ds. epitaksji (K/M) nr naboru N/25/82

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Institut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz-IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 100% etatu

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Institut Mikroelektroniki i Fotoniki,
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Zakres obowiązków:

- Prowadzenie epitaksjalnego wzrostu heterostruktur półprzewodnikowych (III-V) metodami MBE i MOCVD, ze szczególnym uwzględnieniem struktur kwantowych laserów kaskadowych (QCL) i laserów międzypasmowych (ICL)
- Optymalizacja procesów wzrostu, opracowywanie i aktualizacja procedur technologicznych
- Charakteryzacja i analiza parametrów warstw półprzewodnikowych oraz wprowadzanie korekt do procesów
- Serwis i nadzór nad urządzeniami epitaksjalnymi i aparaturą próżniową
- Realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz publikowanie prac naukowych
- Składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych
- Szkolenie i wsparcie merytoryczne członków zespołu
- Udział w pozyskiwaniu zleceń oraz współpraca z klientami i partnerami przemysłowymi

Wymagania:

- Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze B+R albo wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze B+R, w tym udział w realizacji projektów badawczych
- Preferowani absolwenci kierunków: fizyka, fizyka techniczna, elektronika, inżynieria materiałowa
- Minimum 5 lat doświadczenia w pracy nad technologiami wzrostu kryształów i epitaksji heterostruktur półprzewodnikowych
- Znajomość metod MBE i MOCVD oraz technologii ultra wysokiej próżni (UHV)
- Doświadczenie w pracy w środowisku clean-room.
- Dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2)
- Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
- Dokładność, systematyczność oraz zdolność rozwiązywania problemów i przekazywania wiedzy

Wymagane dokumenty:

- CV
- Dyplom ukończenia szkoły/studiów
- Spis osiągnięć naukowo-badawczych, z uwzględnieniem publikacji, patentów i udziału w projektach naukowo-badawczych

Oferujemy:

- Pracę w organizacji realizującej innowacyjne, krajowe i zagraniczne, prestiżowe projekty badawczo-rozwojowe
- Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
- Kulturę wspierającą różnorodność i rozwój
- Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych
- Programy zatrudniania finalistów olimpiad przedmiotowych
- Możliwość realizowania praktyk szkolnych i studenckich
- Dostęp do wydawnictw naukowych
- Elastyczne godziny pracy

Benefity:

- Pakiety medyczne
- Grupowe ubezpieczenie na życie
- Karta sportowa
- Dofinansowanie szkoleń i kursów
- Dodatkowe świadczenia socjalne
- Dofinansowanie wypoczynku
- Świadczenie świąteczne
- Nagrody jubileuszowe
- Dodatkowe dni wolne
- Inicjatywy dobroczynne

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować w formie elektronicznej poprzez poniższy link do dnia 15 grudnia 2025 r.

<https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=408c1affe7b9448780af2e2b171640c4>

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

data publikacji: 8.10.2025